

シングル N チャンネル MOSFET

ELM51432A-S

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM51432A-S は低入力容量、低電圧駆動、低 ON 抵抗という特性を備えた大電流 MOS FET です。

■特長

- ・ Vds=30V
- ・ Id=4.0A
- ・ Rds(on) = 30mΩ (Vgs=10V)
- ・ Rds(on) = 35mΩ (Vgs=4.5V)

■絶対最大定格値

特に指定なき場合、Ta=25°C

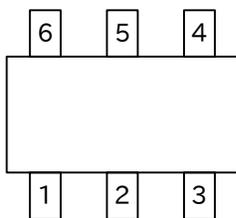
項目	記号	規格値	単位
ドレイン - ソース電圧	Vds	30	V
ゲート - ソース電圧	Vgs	±20	V
連続ドレイン電流 (Tj=150°C)	Id	Ta=25°C	4.0
		Ta=70°C	3.6
パルス・ドレイン電流	Idm	15	A
最大許容損失	Pd	Tc=25°C	1.56
		Tc=70°C	1.00
動作接合部温度	Tj	150	°C
保存温度範囲	Tstg	- 55 ~ 150	°C

■熱特性

項目	記号	Typ.	Max.	単位
最大接合部 - 周囲温度	Rθja		120	°C/W

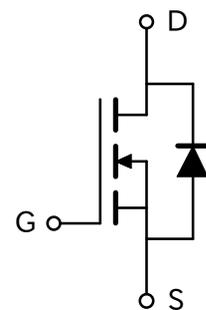
■端子配列図

SC-70-6(TOP VIEW)



端子番号	端子記号
1	DRAIN
2	DRAIN
3	GATE
4	SOURCE
5	DRAIN
6	DRAIN

■回路



シングル N チャンネル MOSFET

ELM51432A-S

<http://www.elm-tech.com>

■電気的特性

特に指定なき場合、 $T_a=25^\circ\text{C}$

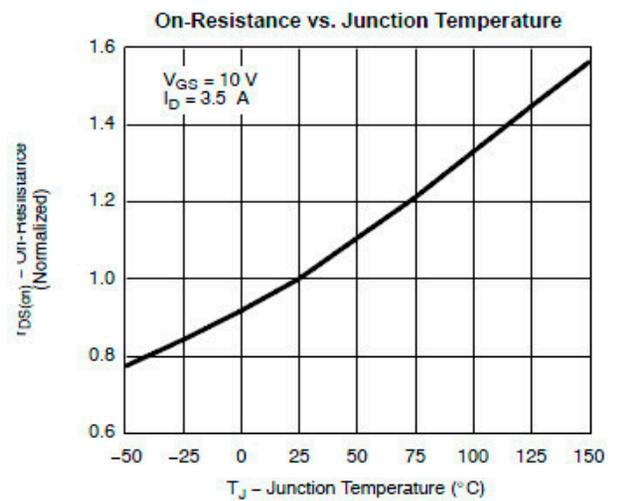
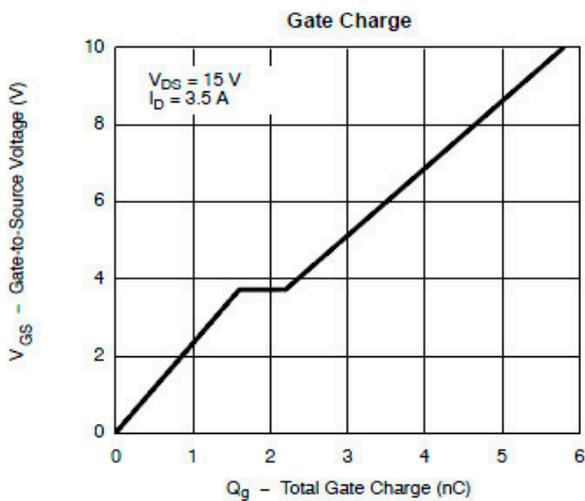
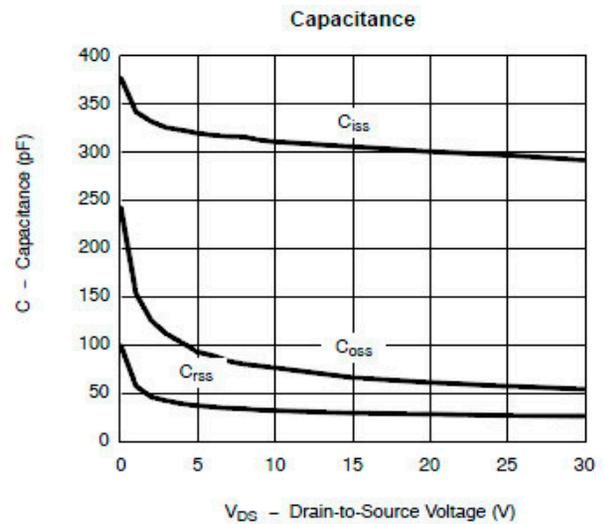
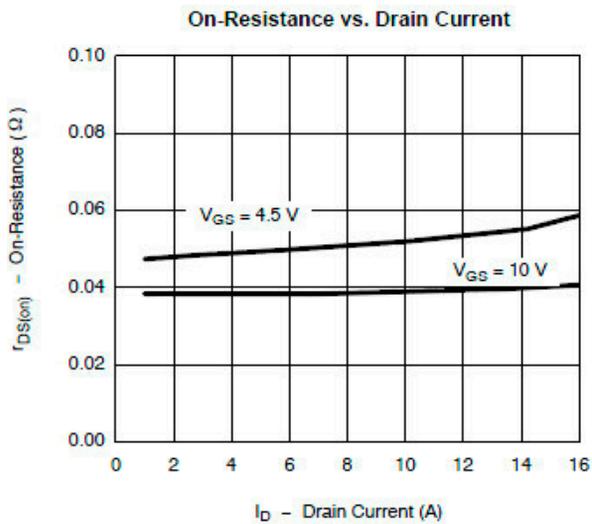
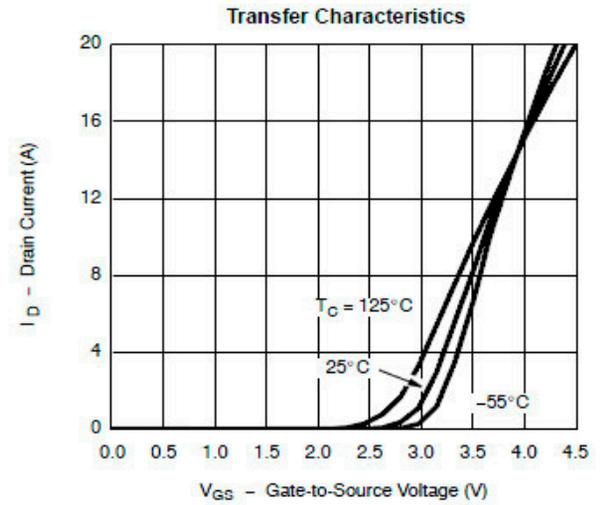
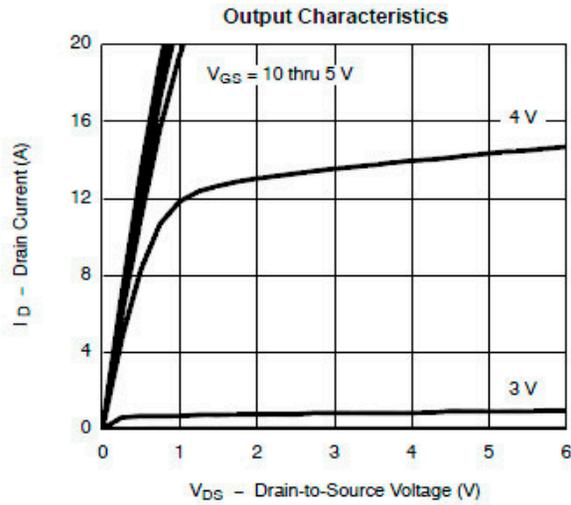
項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
静的特性						
ドレイン・ソース降伏電圧	BVdss	$I_d=250\mu\text{A}, V_{gs}=0\text{V}$	30			V
ゼロ・ゲート電圧ドレイン電流	Idss	$V_{ds}=24\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$			1	μA
		$V_{ds}=24\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_a=85^\circ\text{C}$			30	
ゲート漏れ電流	Igss	$V_{ds}=0\text{V}, V_{gs}=\pm 20\text{V}$			± 100	nA
ゲート・スレッシュホールド電圧	Vgs(th)	$V_{ds}=V_{gs}, I_d=250\mu\text{A}$	1.0		2.0	V
オン状態ドレイン電流	Id(on)	$V_{gs}=10\text{V}, V_{ds}\geq 4.5\text{V}$	6			A
ドレイン・ソースオン状態抵抗	Rds(on)	$V_{gs}=10\text{V}, I_d=4.0\text{A}$		20	30	m Ω
		$V_{gs}=4.5\text{V}, I_d=3.5\text{A}$		25	35	
順方向相互コンダクタンス	Gfs	$V_{ds}=4.5\text{V}, I_d=2.5\text{A}$		8		S
ダイオード順方向電圧	Vsd	$I_s=1.6\text{A}, V_{gs}=0\text{V}$		0.8	1.2	V
最大寄生ダイオード連続電流	Is				1.3	A
動的特性						
入力容量	Ciss	$V_{gs}=0\text{V}, V_{ds}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$		320		pF
出力容量	Coss			70		pF
帰還容量	Crss			30		pF
スイッチング特性						
総ゲート電荷	Qg	$V_{gs}=10\text{V}, V_{ds}=15\text{V}$ $I_d\equiv 2.6\text{A}$		3.0	4.5	nC
ゲート・ソース電荷	Qgs			1.6		nC
ゲート・ドレイン電荷	Qgd			0.6		nC
ターン・オン遅延時間	td(on)	$V_{gs}=10\text{V}, V_{ds}=15\text{V}$ $R_L=15\Omega, I_d\equiv 1.0\text{A}$ $R_{gen}=6.0\Omega$		8	12	ns
ターン・オン立ち上がり時間	tr			12	18	ns
ターン・オフ遅延時間	td(off)			15	30	ns
ターン・オフ立ち下がり時間	tf			8	15	ns

シングル N チャンネル MOSFET

ELM51432A-S

<http://www.elm-tech.com>

■標準特性と熱特性曲線

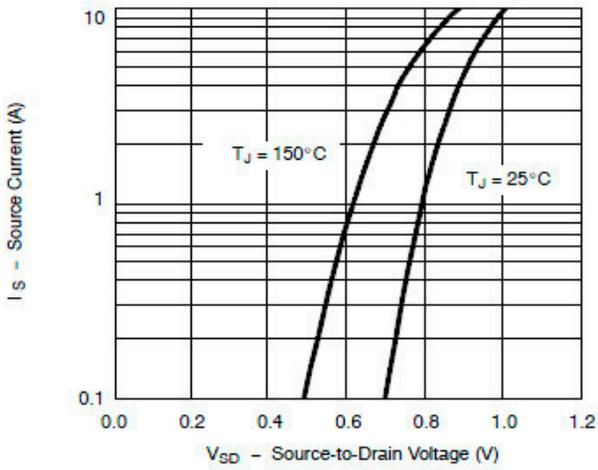


シングル N チャンネル MOSFET

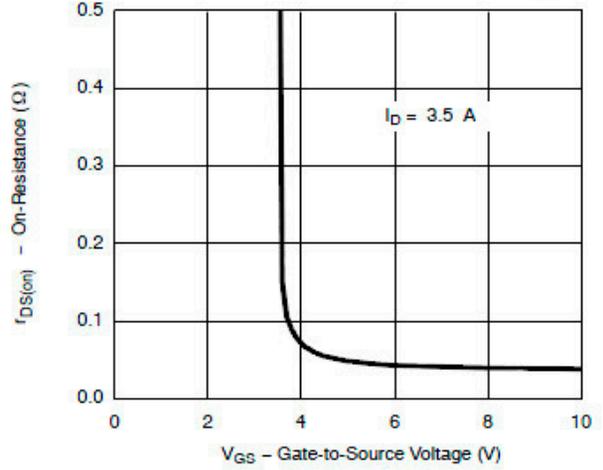
ELM51432A-S

<http://www.elm-tech.com>

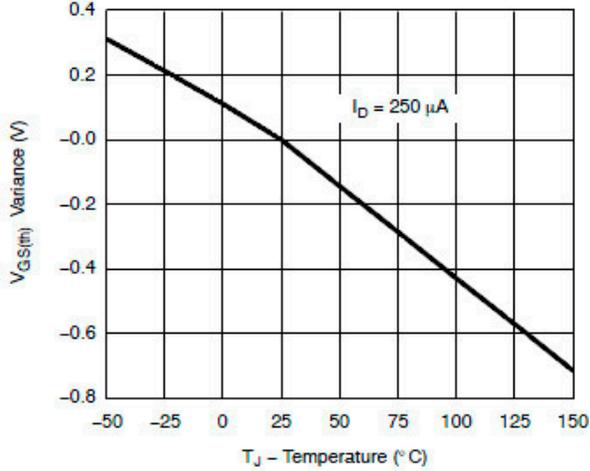
Source-Drain Diode Forward Voltage



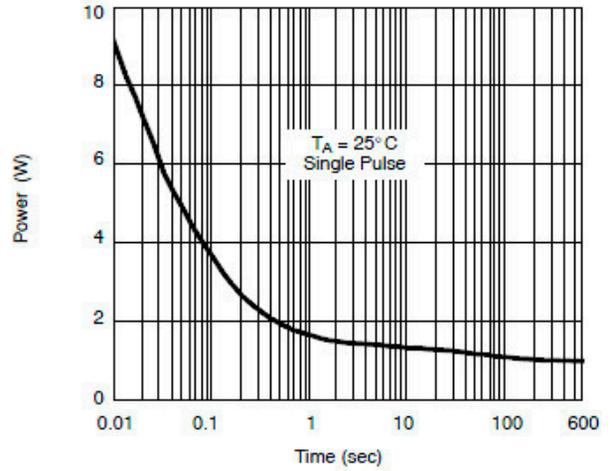
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage



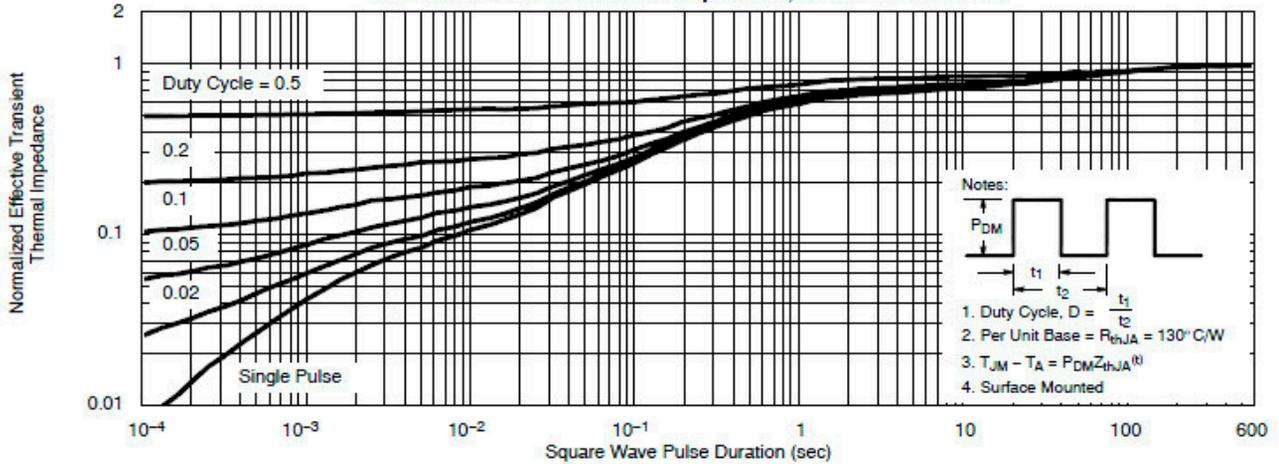
Threshold Voltage



Single Pulse Power



Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient



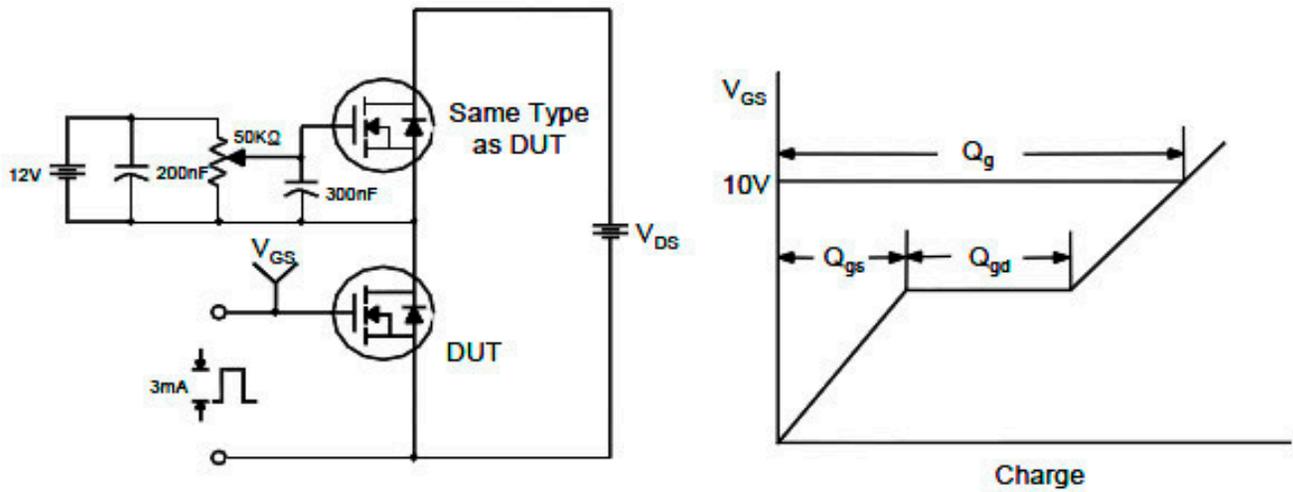
シングル N チャンネル MOSFET

ELM51432A-S

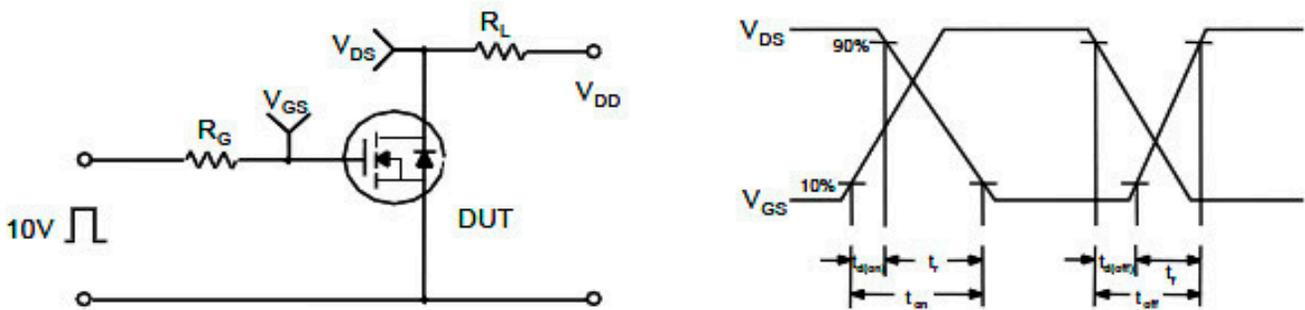
<http://www.elm-tech.com>

■ テスト回路と波形

Gate Charge Test Circuit & Waveform



Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms

